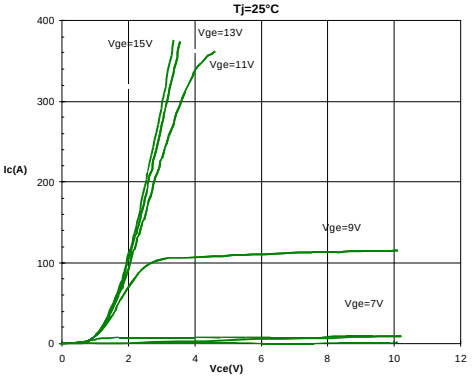
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: OM200F120CMD (Tc= 25°C unless otherwise specified)

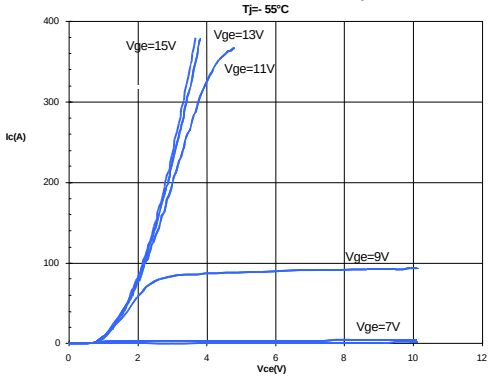
Characteristic		Symbol	Min.	Typ.	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS						
Collector Emitter Breakdown Voltage, V_{CE}=0V		V_{CES}	1200			V
Zero Gate Voltage Drain Current, V_{GE}=0, V_{CE} =1200V		I_{CES}		10		µA
Gate Emitter Leakage Current, V_{GE}=+/-15V, V_{CE}=0V		I_{GES}		100		µA
ON CHARACTERISTICS						
Gate Threshold Voltage, V_{CE}=V_{GE}, I_C=6mA		$V_{GE(TH)}$	4.5	5.5	6.5	V
Collector Emitter Saturation Voltage, V_{GE}=15V, Ic=200A		$V_{CE(SAT)}$		2.5	3.0	V
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Fwd. Transconductance	V_{CE}=5V, I_C=200A	gfs	50	69		S
Input Capacitance	V_{GE}=0	Cies		17		nF
Output Capacitance	V_{CE}=25V	Coes		5		nF
Rev. Transfer Capacitance	f=1.0MHz	Cres		2		nF
SWITCHING INDUCTIVE LOAD CHARACTERISTICS						
Turn-On Delay Time	V_{CC}= 600V, I_C=200A	t(on)		175	400	nS
Rise Time		tr		140		nS
Turn-on Losses	V_{GE}=+15/-10V, R_G=5.1Ω	Eon		28		mJ
	L=100µH					
Turn-off Delay Time		td(off)		720	850	nS
Fall Time		tf		120		nS
Turn-off Losses		Eoff		15		mJ
DIODE CHARACTERISTICS						
Maximum Forward Voltage	I_F=200A, Tj=25°C	V_F		2.0	2.8	V
	Tj=125°C			1.8	2.3	
Reverse Recovery Characteristics	V_R=600V, Tj=25°C	Qrr		10		µC
	I_F=200A, Tj=125°C			15		
	dI/dt=-1500A/µS Tj=25°C	Irr		75		A
	Tj=125°C			95		
	Tj=25°C	trr		100		nS
	Tj=125°C			150		
THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS						
Thermal Resistance, Junction to Case (Per IGBT)		R_{thJC}			0.07	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Case (Per Diode)		R_{thJC}			0.12	°C/W
Maximum Junction Temperature		T_{jMAX}			150	°C
Isolation Voltage		Vis_{RMS}			2500	V
Screw Torque	Mounting	-		15	20	in-lb
Screw Torque (M6)	Terminals			10	12	in-lb
Screw Torque (M3)	Terminals	-		6	8	in-lb
Module Weight		-		320		Grams

OM200F120CMD

IGBT Collector Current vs. Collector-emitter Voltage
Tj=25°C

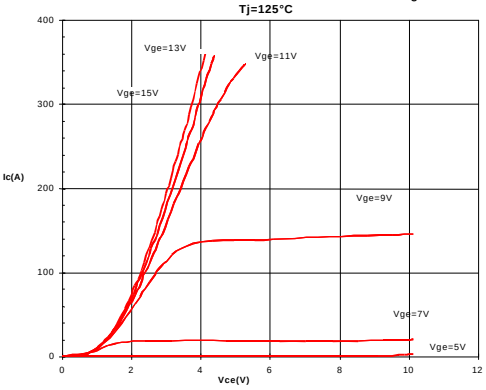


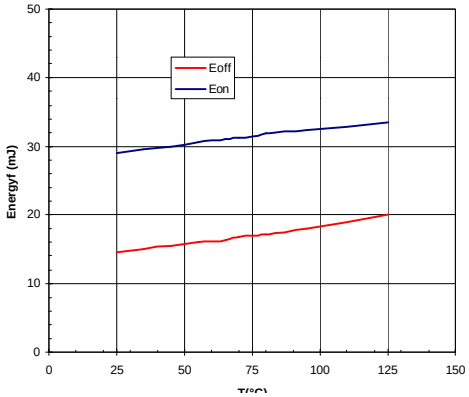
IGBT Collector Current vs. Collector-emitter Voltage
Tj=- 55°C



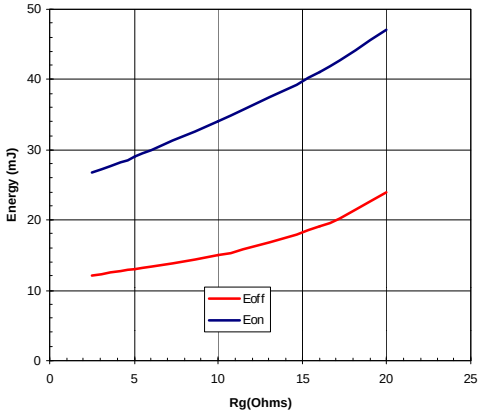
Switching energy vs Temperature
Vce =600V,Ic=200A

IGBT Collector Current vs. Collector-emitter Voltage
Tj=125°C

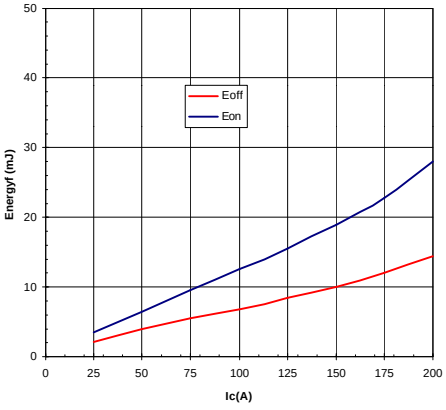




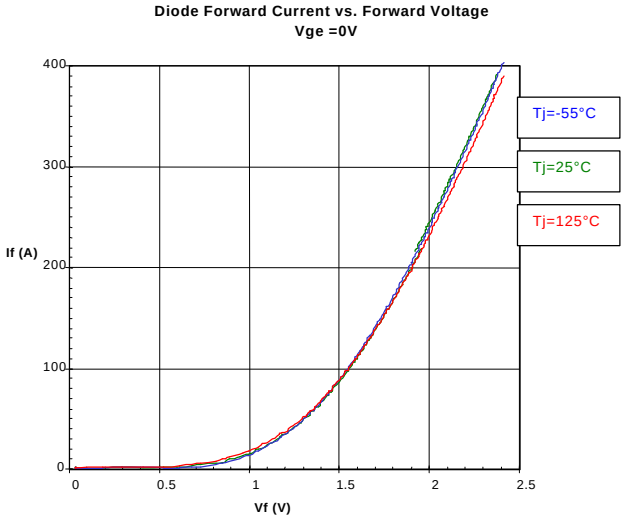
Switching energy vs Gate Resistor(Rg)
Vce =600V,Ic=200A, Tj=125°C



Switching energy vs Collector current (Ic)
Vce =600V,Tj=25°C

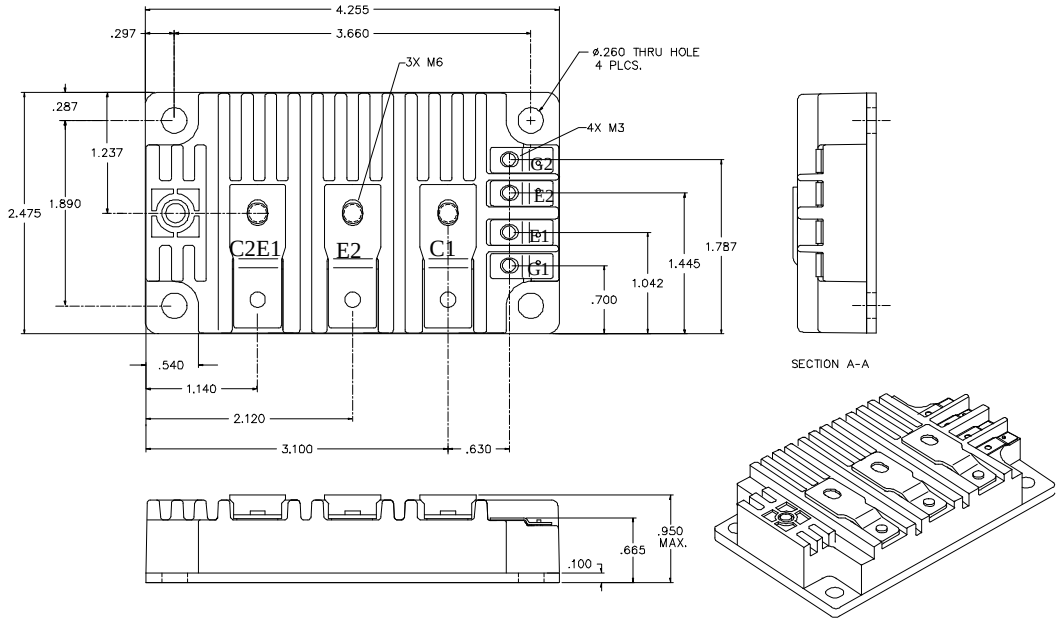


OM200F120CMD

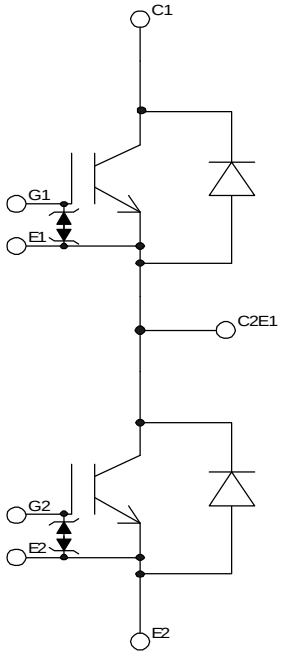


OM200F120CMD

MECHANICAL OUTLINE



EQUIVALENT CIRCUIT



LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru